

СВЕДЕНИЯ

об официальных оппонентах по диссертации
соискателя Тарасова Александра Евгеньевича

на тему «Опτικο-электронный комплекс, обеспечивающий прогнозирование срока службы торцевых лазерных диодов»
по специальности 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы

Фамилия, имя отчество официального оппонента (полностью)	Пихтин Никита Александрович
Дата рождения (дд.мм.гггг), гражданство	17.10.1966, РФ
Ученая степень и ученое звание (при наличии), отрасль наук	Кандидат физ.-маг. наук 01.04.10 Физика полупроводников, 01.04.21 – лазерная физика
Шифр специальности, по которой защищена диссертация	01.04.10 – физика полупроводников
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы, структурное подразделение, должность, почтовый адрес, телефон, электронная почта	Федеральное государственное бюджетное учреждение Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Центра физики наногетероструктур и. о. руководителя Центра физики наногетероструктур 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 + 7-(812)-292-7379 nike@hpld.ioffe.ru
Основные работы по профилю оппонируемой диссертации	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Effect of the Carrier Drift Velocity Saturation in High-Power Semiconductor Lasers at Ultrahigh Drive Currents / Pikhtin N.A., Soboleva O.S., Zolotarev V.V. [and etc.] // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2020. – V. 67. – №. 11. – P. 4977-4982. 2. Triple integrated laser – thyristor / Pikhtin N.A., Bagaev T.A., Ladugin M.A. [and etc.] // Quantum Electronics. – 2020. – V. 50. – №. 11. – P. 1001. 3. Development and study of high-power quantum-cascade lasers emitting at 4.5 – 4.6 mm

- / Pikhtin N.A., Babichev A.V., Pashnev D.A. [and etc.] // Quantum Electronics. – 2020. – V. 50. – №. 11. – P. 989-994.
4. Lasing dynamics of diode-pumped Yb - Er laser with a passive Q switch exposed to high-power external light / Pikhtin N.A., Batura E.O, Bobretsova Yu.K. [and etc.] // Quantum Electronics. – 2020. – V. 50. – №. 9. – P. 822-825.
 5. Leaky wave in high-power AlGaAs/InGaAs/GaAs semiconductor lasers / Pikhtin N.A., Bobretsova Yu.K., Veselov D.A. [and etc.] // Quantum Electronics. – 2020. – V. 50. – №. 8. – P. 722-726.
 6. 10-W 4.6- μm quantum cascade lasers / Pikhtin N.A., Dudelev V.V., Mikhailov D.A. [and etc.] // Quantum Electronics. – 2020. – V. 50. – №. 8. – P. 720-721.
 7. Study of the Spatial and Current Dynamics of Optical Loss in Semiconductor Laser Heterostructures by Optical Probing / Pikhtin N.A., Gavrina P.S., Soboleva O.S. [and etc.] // Semiconductors. – 2020. – V. 54. – №. 8. – P. 882-889.
 8. Spectral Dynamics of Quantum Cascade Lasers Generating Frequency Combs in the Long-Wavelength Infrared Range / Pikhtin N.A., Dudelev V.V., Mikhailov D.A. [and etc.] // Technical Physics. – 2020. – V. 65. – №. 8. – P. 1281-1284.
 9. Spectral Characteristics of Half-Ring Quantum-Cascade Lasers / Pikhtin N.A., Babichev A.V., Pashnev D.A. [and etc.] // Optics and Spectroscopy. – 2020. – V. 128. – №. 8. – P. 1187-1192.
 10. Study of the Spectra of Arched-Cavity Quantum-Cascade Lasers Pikhtin N.A., Babichev A.V., Pashnev D.A. [and etc.] // Optics and Spectroscopy. – 2020. – V. 128. – №. 6. – P. 702-706.

Патент:

1. Импульсный инжекционный лазер / Рожков А.В., Пихтин Н.А. // Патент на изобретение RU 2691164 С1, 11.06.2019. Заявка № 2018110904 от 27.03.2018.
2. Инжекционный лазер с переключаемым спектром генерации / Веселов Д.А., Слипченко С.О., Пихтин Н.А. // Патент на полезную модель RU 184264 U1, 19.10.2018. Заявка № 2018116720 от 04.05.2018.
3. Инжекционный лазер с переключаемым спектром генерации / Веселов Д.А.,

	Слипченко С.О., Пихтин Н.А. // Патент на полезную модель RU 183644 U1, 28.09.2018. Заявка № 2018107623 от 01.03.2018.
Индекс Хирша	(по Scopus) 17
Индекс цитируемости за последние 5 лет (по данным РИНЦ)	18

Подпись официального оппонента  (Пихтин Н.А.)

Подпись Слипченко С.О. заверяю

Заведующий отделом кадров

ФТИ им. А.Ф. Иоффе



21.01.2021

